

IGBT ТРАНЗИСТОРЫ



IGBT транзисторы фирмы **Infineon** выполнены по NPT технологии, которая позволила значительно улучшить рабочие характеристики приборов.

IGBT транзисторы выпускаются в разнообразных корпусах. Технология EmCon фирмы Infineon позволяет интегрировать в одном корпусе транзистор и быстродействующий обратный диод.

Диапазон рабочих токов 2–30 А, рабочее напряжение до 1200 В.

Диапазон рабочих температур: -55...+150°C.

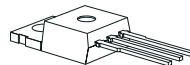
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

SG	P	30	N	120
-----------	----------	-----------	----------	------------

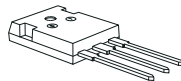
- Тип транзистора**
 BUP - IGBT
 SG - быстродействующий IGBT
 SK - быстродействующий IGBT с обратным диодом
- Тип корпуса:** D – TO-252AA, I – TO-262, B – TO-263AB, P (или 2) – TO-220AB, W – TO-247AC, 3 – TO-218AB
- Ток коллектора, А**
- Напряжение коллектор-эмиттер (x10), В**

Наименование	Частотный диапазон, кГц	Напряж. коллектор-эмиттер, В	Напряжение коллектор-эмиттер (откр.), В	Ток коллектора, А	Мощность рассеивания, Вт	Тип корпуса	Семейство	
BUP212	10	1200	3.4	22	125	TO-220AB	IGBT	
BUP213			3.3	32	200			
BUP313			3.4	32	200			
BUP314			TO-218AB	3.4	52	300		
BUP311D				3.4	20	125		
BUP313D				3.4	32	200		
BUP314D				3.4	42	300		
SGP30N60	30	600	2.5	30	250	TO-220AB	быстродействующий IGBT	
SGW30N60						TO-247AC		
SGP02N120		1200	3.1	2	62	TO-220AB		
SGP07N120		1200	3.1	7	125	TO-220AB		
SGW25N120		1200	3.1	25	313	TO-247AC		
SKP15N60		600	2.3	15	139	TO-220AB		быстродействующий IGBT с обратным диодом
SKW25N120		1200	3.7	25	313	TO-247AC		

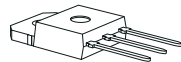
ТИПЫ КОРПУСОВ



TO-220AB



TO-247AC



TO-218AB